

УТВЕРЖДАЮ

Начальник НТЦ «НИИРП»

ПАО «НПО «Алмаз»

кандидат технических наук

Г.В. Соколов

15. 11. 2021 г.



ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Ястребцовой Ольги Игоревны, выполненной на тему «Микрополосковые антенные решётки с двухслойной диэлектрической подложкой», представленной к защите на соискание учёной степени кандидата технических наук по специальности 2.2.14 – «Антенны, СВЧ-устройства и их технологии»

В современных системах связи, в частности, в сотовых системах связи на базовых станциях, в системах широкополосного беспроводного доступа, для земных станций систем спутниковой службы все большее распространение получает использование сканирующих антенных решеток. В связи с этим решение вопроса улучшения широкоугольных свойств таких антенных решёток является **актуальным**.

Одним из таких типов антенных решеток являются микрополосковые, которым, однако, может быть свойственен эффект «ослепления», проявляющийся при использовании сравнительно толстых диэлектрических подложек, необходимых для расширения рабочей полосы.

В связи с этим в диссертации была поставлена следующая **цель**: решение научной задачи расширения широкоугольных свойств микрополосковых фазированных антенных решеток за счет увеличения угла «ослепления» путём перехода от однослойной к двухслойной диэлектрической подложке.

Автором были решены следующие **научные задачи**:

1. Научное обоснование и сравнение ограничений, накладываемых эффектом «ослепления» на сектор углов сканирования микрополосковых фазированных антенных решёток (ФАР) с однослойной и двухслойной подложками.

2. Развитие возможностей применения двухслойной диэлектрической подложки в микрополосковых ФАР для увеличения углов «ослепления».

3. Проведение сравнительного анализа глубины провала в диаграмме направленности центрального элемента микрополосковой ФАР с однослойной и двухслойной диэлектрическими подложками вследствие влияния эффекта «ослепления».

Отдел документационного
обеспечения МАИ

16 11 2021

4. Разработка нового подхода к определению влияния эффекта «ослепления» на коэффициент усиления микрополосковых ФАР с однослойной и двухслойной диэлектрическими подложками в широком секторе углов сканирования.

5. Разработка нового алгоритма решения задачи выбора совокупности параметров двухслойной диэлектрической подложки по заданному уровню снижения коэффициента усиления микрополосковой ФАР в широком секторе углов сканирования.

В результате проведенных исследований были получены следующие научные результаты:

1. Применение двухслойных диэлектрических подложек для микрополосковых ФАР позволяет увеличить угол «ослепления» на величину до 42 градусов при полуволновом периоде антенной решетки и на величину до 32 градусов при периоде решетки $0,6\lambda$ по сравнению с микрополосковыми ФАР с однослойными диэлектрическими подложками той же толщины с той же относительной диэлектрической проницаемостью, что и верхний слой двухслойной диэлектрической подложки.

2. Сектор углов сканирования микрополосковых ФАР с однослойной и двухслойной диэлектрическими подложками при угле «ослепления», равном 50 градусам, сокращается на 12 градусов при допустимом уровне неравномерности коэффициента усиления в секторе 3 дБ и на 4 градуса при допустимом уровне неравномерности коэффициента усиления 1 дБ по сравнению с идеализированным случаем использования диаграммы направленности одиночного элемента.

3. Разработанный алгоритм определения параметров двухслойной диэлектрической подложки по заданному уровню неравномерности коэффициента усиления микрополосковой ФАР из прямоугольных патч-излучателей позволяет получить заданный сектор углов сканирования с погрешностью не более 4 градусов.

Практическая значимость диссертации состоит в демонстрации возможности использования в микрополосковых ФАР сравнительно толстых подложек и больших значений относительной диэлектрической проницаемости подложки без эффекта «ослепления» при переходе к двухслойной подложке, что подтверждено результатами моделирования.

Достоверность полученных в диссертации результатов и выводов определяется значительным количеством экспериментального и научно-методического материалов, на основе которых они выполнены.

По теме диссертации автором опубликовано 27 статей в 11 научных изданиях, из которых 6 работ опубликовано в российских рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации, 2 публикации проиндексированы в Scopus. Основные результаты диссертации были доложены на 13 отечественных и международных научно-технических конференциях.

Количество публикаций и аprobаций результатов исследования является достаточным.

Содержание автореферата соответствует специальности, по которой диссертация представляется к защите.

Вместе с тем по содержанию автореферата можно сделать следующие **замечания**.

1. Как известно, эффект «ослепления» существенным образом зависит от вида координатной сетки, используемой при построении ФАР. Из текста автореферата следует, что автором рассмотрена только ФАР с прямоугольной сеткой расположения элементов и не рассмотрены другие варианты построения излучающего полотна ФАР.

2. Из текста автореферата неясно, рассматривался ли сдвиг углов «ослепления» с изменением частоты.

Указанные недостатки автореферата не снижают научной и практической значимости диссертации.

Все изложенные автором в автореферате диссертации полученные основные научные результаты достаточно полно отражены, логично и наглядно показаны, даны рекомендации по их применению.

В целом, судя по автореферату, диссертация Ястребцовой О.И. актуальна, содержит ряд новых научных результатов. Уровень изложенных в работе результатов и их значимость соответствуют требованиям п. 9, абз. 2 «Положения о присуждении ученых степеней», профилю указанной специальности, а ее автор Ястребцова О.И. заслуживает присуждения учёной степени кандидата технических наук по специальности 2.2.14 – «Антенны, СВЧ-устройства и их технологии».

Кандидат технических наук доцент
Ведущий научный сотрудник СКБ-270
ПАО «НПО «Алмаз»

Голубчиков Сергей Викторович

Ф.И.О.: Голубчиков Сергей Викторович
Название организации: Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (ПАО «НПО «Алмаз»)

Адрес: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16

Телефон: +7 (499) 940-02-22

e-mail: sb45@gskb.ru